Searching PAJ

1/2 ページ



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 1

11-143070

(43) Date of publication of application: 28.05.1999

(51)Int.CL

603F G03F 7/022 7/027 **603F** 603F 7/26 HO1L 21/027 // C09D177/06

(21)Application number : 10-236711

· (71)Applicant : SUMITOMO BAKELITE CO LTD

(22)Date of filing:

24.08,1998

(72)Inventor: MAKABE HIROAKI

TAKEDA NAOJI

BANBA TOSHIO

HIRANO TAKASHI

(30)Priority

Priority number: 09236684

Priority date: 02.09.1997

Priority country: JP

(54) POSITIVE PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a pattern high in resolution and film endurance and superior in adhesion to a blocking resin and high in sensitivity to ultraviolet exposure by incorporating each specified amount of a specified polyamide and a specified sulfonate ester and a specified phenol compound.

SOLUTION: This photosensitive resin composition contains 100 pts.wt. of the polyamide (A) represented by formula I, 1-50 pts.wt. of the 1.2- naphthoquinone-2-diazido-4-sulfate ester (B), 1-50 pts.wt. of the 1,2- naphthoquinone-2-diazido-5-sulfonnate ester (C) and 1-30 pts.wt. of the phenol compound (D) represented by formula II. In the formula I, X is a tetravalent cyclic group; Y is a divalent cyclic group; Z is represented by formula III; E is an aliphatic or cyclic group having an alkenyl or alkynyl group; each of (a) and (b) is a mol fraction and (n) is 2-500. In the formula II, each of R5 and R6 is an H atom or an alkyl group; and each of R7-R10 is an H or halogen atom or the like.

П

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.05,2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Searching PAJ ·

2/2 ページ

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-143070

(43)公開日 平成11年(1999)5月28日

		•								
(51)IntCl.4		識別記号		FΙ						
GOSF	7/037			G0:	3 F	7/037				
	7/022					7/022				•
	7/027	514				7/027		514		•
	7/28	501				7/26		501		
H01L	21/027			C 0 9 D 177/08						
			级在部块	未留求	MIN.	夏の数10	OL	(全28頁)	河连线员	こ説ぐ
(21)出度番号		特 <u>阿</u> 平10-236711		(71)	出頭人	000002	141		··· -	
						住友ペークライト株式会社				
(22)出籍日		平成10年(1998) 8月24日								
				(72)	発明者	建英	谷明		 -	
(31) 優先権主張委号		特度平9-236684	•			東京都	品川区	東品川2丁目	5茶8号	住友
(32)優先日		平9 (1997) 9月2日		.		ベーク	ライト	株式会社内		
(33) 優先指主張国		日本(JP)		(72)	発明者	竹田	性性			
		•				東京都	岛川区	取品川2丁目	5番8号	住友
						ペーク	ライト	株式会社内		
		•	·	(72)	発明者	母場	放头			
		•				東京都		求品川2丁 目	5番8号	住友
		•				ベーク	ライト	株式会社内		
						最終質に続く				に続く
				1						

(54) 【発明の名称】 ポジ型感光性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 高解像度で高残膜率のパターンを得ることができ、かつ封止樹脂との密着性に優れており、波長が365mmの紫外線露光において高速度であるポジ型感光性樹脂を提供する。

【解決手段】 一般式 (1) で示されるポリアミド (A) 100 国量部と1, 2ーナフトキノンー2ージアジドー4ースルホン酸エステル化合物 (B) 1~50 国量部と1, 2ーナフトキノンー2ージアジドー5ースルホン酸エステル化合物 (C) 1~50 国量部と一般式 (2) で表されるフェノール化合物 (D) 1~30 国景部とからなることを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

[461]

(大中、礼、礼は本本原子士を)とかれる小性を表し、 礼。礼、礼、礼はとかぞれ本京原子、〜セゲン原子、本田区、 アルベル系、アルコヤンズ、ッチロアル今かまのがから過せれ

(2)

特闘平11-14307C

【特許請求の範囲】

【韵水項1】 一般式 (1) で示されるポリアミド (A) 100重量部と1, 2ーナフトキノンー2ージア ジドー4ースルホン酸エステル化合物 (B) 1~50重量部と1.2ーナフトキノンー2ージアジドー5ースルキ

*ホン酸エステル化合物 (C) 1~50重量部と一般式 (2) で表されるフェノール化合物 (D) 1~30 乗量 部とからなることを特徴とするポン型感光性樹脂組成 物。

(化1)

式中 X:4価の泉式化合物基 Y:2価の環式化合物基 (1)

$$Z: -R_1 - \begin{cases} R_3 & R_3 \\ 1 & 1 \\ si - 0 - si - R_2 - - - \\ 1 & 1 \\ R_4 & R_4 \end{cases}$$

(R₁、R₂:2価の有機基、R₃、R₄:1価の有機基)

E:アルケニル基又はアルキニル基を少なくとも1個を有する 脂肪族又は環式化合物基

a、b はモル分率を示し、a+b=100モル% a=60.0~100.0モル% b=0~40.0モル% n=2~500

【化2】

$$\begin{array}{c|c}
CH & R_5 & R_9 \\
\hline
R_8 & R_{10} & C
\end{array}$$
(2)

(式中、R₆、R₈は水素原子またはアルキル基を表し、

R₇、R₈、R₉、R₁₀はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、水酸基、アルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基の内から選ばれ

た1つを示す)

【請求項2】 一般式 (1) のポリアミドにおけるX が、下記より選ばれてなる請求項1記蔵のポジ型感光性 樹脂組成物。

[化3]

村毘平11−143070

【請求項3】 一般式(1)のポリアミドにおけるY が、下記より選ばれてなる請求項1又は2記載のポジ型#

$$-\langle \bigcirc \rangle$$
- \circ - $\langle \bigcirc \rangle$ -

+感光性樹脂組成物。 【化4】

【 請求項4 】 一般式(1)のポリアミドにおけるEが、下記より選ばれてなる請求項1、2又は3記載のポッ型級光性樹脂組成物。

[化5]

【請求項5】、1、2ーナフトキノンー2ージアジドー

4-スルホン酸エステル化合物(B)と1,2-ナフトキノン-2-ジアジド-6-スルホン酸エステル化合物(C)の配合比率が重型比で1≤(C)/(B)≤10であることを特徴とする請求項1、2、3又は4記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【請求項6】 1,2ーナフトキノンー2ージアジドー4ースルホン酸エステル化合物(B)が、下記より選ばれてなる請求項1、2、3、4又は5記載のポジ型感光性樹脂組成物。

化61

(4)

特開平11-143070

(式中Q1は水索原子又は

を意味し、Q,の少なくとも1つは、

を意味する。)

【請求項7】 1, 2ーナフトキノンー2ージアジドー5ースルホン酸エステル化合物(C)が、下記より選ばれてなる請求項1、2、3、4、5又は6記載のポジ型

感光性樹脂組成物。 【化7】

(5)

特開平11-143070

(式中Qzは水衆原子又は

を意味し、Q2の少なくとも1つは、

を意味する。)

【請求項8】 1,2ーナフトキノンー2ージアジドー4ースルホン酸エステル化合物(B)と1,2ーナフトキノンー2ージアジドー5ーフルナン酸エステルル合物

合物である請求項6又は7記載のボジ型感光性樹脂組成物。

キノンー2ージアジドー5ースルホン酸エステル化合物 40 【化8】

(C) が、それぞれ一般式 (3)、(4) で表される化

(6)

特朗平11-143070

(式中Q1は水素原子又は

$$\bigcirc \bigvee_{SO_2}^{O} N_2$$

を意味し、Q」の少なくとも1つは、

$$\bigcirc \bigvee_{SO_2}^{N_2}$$

を意味する。)

(式中Qaは水素原子又は

を意味し、Q₂の少なくとも1つは、

を意味する。)

【請求項9】 フェノール化合物 (D) が、一般式

(5) で表されるフェノール化合物である請求項1記載

[化9] HO OH

のポジ型感光性樹脂組成物。

(5)

【請求項10】 フェノール化合物(D)が、一般式 (6) 又は(7) で表される化合物であり、単独又は混 合物の形で、フェノール化合物 (D) 全体の50 重量% 以上を含む翻求項1又は9記載のポジ型感光性樹脂組成 物。

【化10】

-143070

+性及び保存安定性に優れた高感度のポジ型感光性樹脂組 成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体案子の設面保護膜、層間絶 録膜には耐熱性が優れ、又卓越した電気特性、機械特性 等を有するポリイミド樹脂が用いられているが、近年半 導体索子の高集積化、大型化、バッケージの薄型化、小 型化、半田リフローによる表面実験への移行等により耐 熱サイクル性、耐熱ショック性等の若しい向上の要求が 10 あり、更に高性能の樹脂が必要とされるようになってき た。一方、ポリイミド樹脂自身に感光性を付与する技術 が最近注目を集めてきており、例えば下記式(8)に示 される感光性ポリイミド樹脂が挙げられる。

[0003]

【化11】

【発明の詳細な説明】 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高解像度で高残膜 率のパターンを得ることができ、かつ封止樹脂との密着 #

【0004】これを用いるとパターン作成工程の一部が **簡略化でき、工程短縮および歩留まり向上の効果はある** が、現像の際にNーメチルー2ーピロリドン等の溶剤が 必要となるため、安全性、取扱い性に問題がある。そこ で最近、アルカリ水溶液で現像ができるポジ型の感光性 樹脂が開発されている。例えば、特公平1-46862 **号公報においてはベース樹脂であるポリベンソオキサソ** 一ル前駆体と感光材であるジアソキノン化合物より構成 されるポジ型感光性樹脂が開示されている。これは高い 耐熱性、優れた電気特性、微細加工性を有し、ウェハー コート用のみならず層間絶縁用樹脂としての可能性も有 している。このポジ型の磁光性樹脂の現像メカニズム は、未露光部のジアソキノン化合物はアルカリ水溶液に 不溶であるが、露光することによりジアゾキノン化合物 が化学変化を起こし、アルカリ水溶液に可溶となる。こ の露光部と未臨光部との溶解性の差を利用し、露光部を 溶解除去することにより未露光部のみの陰臓バターンの 作成が可能となるものである。これらば光性樹脂を実際 に使用する場合、特に重要となるのは感光性樹脂の感度

である。低感度であると、醤光時間が長くなりスル ットが低下する。そこで感光性樹脂の感度を向上させよ うとして、例えばベース樹脂の分子鼠を小さくすると、 現像時に未露光部の膜減りが大きくなるために、必要と される膜障が得られなかったり、ペターン形状が崩れる といった問題が生じる。また、感光材として1、2ーナ フトキノンー2ージアジドー4ースルホン酸エステル化 合物を単独で使用する場合、忽光部の溶解性が増すばか りでなく、未露光部の溶解性も増大するためにパターン 形状が悪くなり、結果として低解像度となる問題が生じ る。この様なことから、上記特性を満足しながら高感度 である感光性樹脂の開発が強く望まれている。又このよ うな感光性樹脂を半導体素子の表面保護膜として用いた 場合、特に問題となるのは後工程でその上に成形される バッケージ用封止樹脂との密着性である。密着性が悪い とその界面で剥離が発生し、半導体パッケージがクラッ クしたり、そのクラックに水が進入し半導体の電気的不 良を発生したりする。

[0005]

(8)

特開平11-143070

【差明が解決しようとする課題】本発明は、高解像度で 高残膜率のパターンを得ることができ、かつ封止機能と

の密着性に優れており、彼長が365nmの紫外線露光 において高感度であるポジ型感光性樹脂を提供すること を目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、一般式 (1) で示されるポリアミド (A) 100 無量部と1,2ーナ*

#フトキノン-2-ジアジド-4-スルホン酸エステル化合物(B)1~50度量部と1、2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホン酸エステル化合物(C)1~50度量部と一般式(2)で表されるフェノール化合物(D)1~30度量部とからなることを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物に関するものである。

(1)

[0007]

【化12】

式中X:4価の環式化合物基 Y:2価の環式化合物基

 $z: -R_1 - \begin{cases} R_3 & R_3 \\ I & I \\ Si - O - Si - R_2 - I \\ I & I \\ R_4 & R_4 \end{cases}$

(R₁、R₂:2価の有機基、R₃、R₄:1価の有機基)

E:アルケニル基又はアルキニル基を少なくとも1個を有する 脂肪族又は環式化合物基

a、b はモル分率を示し、a+b=100モル% a=60.0~100.0モル% b=0~40.0モル% n=2~500

[0008]

 $\begin{array}{c|c}
C & R_9 \\
\hline
C & R_8 \\
\hline
R_8 & R_{10}
\end{array}$ (2)

(式中、 R_5 、 R_6 は水素原子またはアルキル基を表し、

 R_7 、 R_8 、 R_9 、 R_{10} はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、水酸基、

アルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基の内から選ばれ

た1つを示す)

【0009】式(1)のポリアミドは、Xの構造を有す 酸と、更にるビスアミノフェノールとYの構造を有するジカルボン 50 リアミド

酸と、更にEの構造を有する酸無水物からなり、このポリアミドを約300~400℃で加熱すると脱水閉環

特開平11-143070

し、ポリベンソオキサソールという耐熱性樹脂に変化す

る。本発明のポリアミド (1) のXは、例えば、

* [0010] [化14]

16

(式中A: --CH₂--, --C(CH₃)₂--, -

 $-NHCO-, -C(CF_3)_2-)$

【0011】等であるがこれらに限定されるものではな **% [0012]** い。これら中で特に好ましいものとしては、

【化15】

O O CF₃

CH₃

【0013】より選ばれるものである。又式(1)のY は、例えば、

[0014] 【化16】

(10)

特別平11-143070

(武中A: —CH₂—, —C(CH₂)₂—, —O—, —S— ,—SO ₂—,—CO—, —NHCO—, —C(CF₃)₂—)

【0015】等であるがこれらに限定されるものではない。これらの中で特に好ましいものとしては、

* [0016] 【化17】

$$- \bigcirc$$

【0017】より選ばれるものである。又式 (1) のEは、例えば、

[0018] [化18]

【0019】 等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。この中で特に好ましいものとしては、

[0020] [化19]

HC C-OH

С-ОН

アミノフェノールを反応させてポリアミドを合成した 60 後、式(1)のBに示すアルケニル基又はアルキニル基 を少なくとも1個有する酸無水物を用いて末端のアミノ 基をキャップするものである。更に、式(1)の2は、 例えば

[0022] [(£20]

【0021】より選ばれるものである。本発明はYの構造を有するジカルボン酸誘導体とXの構造を有するビス 50

22 【0023】 等であるがこれらに限定されるものではない。式(1)の乙は、例えば、シリコンウェハーのような悲板に対して、特に優れた恋若性が必要な場合に用いるが、その使用割合もは最大40.0 モル%までである。40.0 モル%を越えると樹脂の溶解性が爆めて低下し、現像残り(スカム)が発生し、バターン加工ができない。なお、これらX、Y、E、Zの使用にあたっては、それぞれ1種類であっても2種類以上の混合物であっても構わない。

10 【0024】本発明で用いる1,2ーナフトやノンー2 ージアジド化合物は、米国特許明細書第2,772,9 72号、第2,797,213号、第3,669,65 8号により公知の物質である。例えば、下記のものが挙 げられるがこれらに限定されるものではない。

[0025] 【化21】

-12-

特別平11-143070

[0026]

【化22】

[0027]

-14-

【化23】

(15)

特別平11-143070

ズ中Qは水素原子又は

各化合物においてそれぞれ少なくとも1つは、

$$\bigcup_{SO_2}^{N_2} N_2$$

である。

【0028】これらの中で特に高感度、高残腹率の点から好ましいものとしては下記のものが挙げられる。

[0029] [化24]

(16)

松開平11-143070

を意味し、Q1の少なくとも1つは、

$$\bigcup_{SO_2}^{\circ} N_2$$

を意味する。)

(式中Qaは水溶原子又は

を意味し、Q2の少なくとも1つは、

を意味する。)

 $Q_1O \longrightarrow CH_3$ $H_3C \longrightarrow CH_3$ (3)

【0030】また、1,2ーナフトキノンー2ージアジドー4ースルホン酸化合物(B)と1,2ーナフトキノンー2ージアジドー5ースルホン酸化合物(C)のポリアミド(A)への配合量は、ポリアミド100重量部に対してそれぞれ1~50重量部である。配合量が両方とも1 重量部未満だと樹脂のパターニング性が不良となり、逆に50重量部を越えると感度が大幅に低下するだけでなく、対止樹脂との密着性やフィルムの引っ張り伸び率が若しく低下する。

【0031】1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-4-スルホン酸化合物(B)と1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホン酸化合物(C)の配合比率は、重量比で1≤(C)/(B)≤10の範囲内で使用

する。(C) / (B) が 1 宋満の場合には、宋露光部の 溶解性が増大するために良好なパターンが維持できずに 結果として低解像度となり、逆に (C) / (B) が 1 0 を越えると高感度化への寄与は殆ど認められなくなる。 【0032】本発明のポジ型感光性樹脂組成物には、必要により感光や性を高めるためにジヒドロビリジン誘導体を加えることができる。ジヒドロビリジン誘導体としては、例えば2、8ージメチルー3、5ージアセチルー4ー(2'ーニトロフェニル)ー1、4ージヒドロビリジン、4ー(2'ーニトロフェニル)ー2。6ージメチルー3、5ージカルボエトキシー1、4ージヒドロビリジン、4ー(2'、4'ージニトロフェニル)ー2。6ージメチルー3、5ージカルボエトキシー1、4ージヒドロビリンン、4ー(2'、4'ージニトロフェニル)ー2。6ージメチルー3、5ージカルポメトキシー1、4ージヒ

50

(4)

CH,

(17)

特閉平11-143070

31

ドロビリジン等を挙げることができる。

【0033】本発明のポジ型感光性樹脂組成物において は更に一般式(2)で示されるフェノール化合物を含有* *させることが重要である。

【0034】 【化25】

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & R_9 \\
OH & R_6 & R_{10}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_9 & OH \\
R_8 & R_{10}
\end{array}$$
(2)

(式中、Rs. Reは水素原子またはアルキル基を表し、

 R_7 、 R_8 、 R_9 、 R_{10} はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、水酸基、

アルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基の内から選ばれ

た1つを示す)

【0035】フェノール化合物類をポジ型レジスト組成物に添加する技術としては、例えば、特開平3-200252号公報、特開平3-200253号公報、特開平3-200254号公報、特開平3-200254号公報、特開平4-1650号公報、特開平4-11260号公報、特開平4-12356号公報、特開平4-12357号公報に示されている。しかし、これらに示されているようなフェノール化合物は、本発明におけるポリアミドをベース樹脂としたポジ型感光性樹脂に用いても感度向上の効果は小さい。しかし、本発明における一般30式(2)で表されるフェノール化合物を用いた場合、露光部における溶解速度が増して感度が向上する。また分

子母を小さくして感度を上げた場合に見られるような未 窓光部の膜域りも非常に小さい。また本発明において、 一般式 (2) で表されるフェノール化合物を添加するこ とによる新たな特性として、對止樹脂との密着性が向上 したポジ県感光性樹脂組成物が得られるということを見 いだした。

【0036】一般式(2)に示されるフェノール化合物 としては下記のものを挙げることが出來るがこれらに限 定されない。

30 【0037】 【化26】

[0038]

m,n;1,2

(化27)

[0040]

【化28】

【0041】これらの中で、特に感度および残膜率の点 * 【0042】 で好ましいものとしては、 *20 【化30】

$$CH_2$$
 OH (6)

【0043】であり、一般式(6)又は(7)で表される化合物は単独、または混合物の形で全フェノール化合物(D)中に50重量%以上含まれるものである。フェノール化合物(D)の添加量は、一般式(1)で示されるポリアミド100重量部に対して1~30重量部が好ましい。フェノール化合物の添加量が30重量部が好ましい。フェノール化合物の添加量が30重量部が好ましい。フェノール化合物の添加量が30重量部が好ましい。フェノール化合物の添加量が30重量部より多いと、現像時に苦しい残膜率の低下が起こったり、冷凍保存中において折出が起こり実用性に欠ける。添加量が1重量部未満では、封止樹脂との密着性が低下するばかりか現像時における感度が低下する。

【0044】本発明におけるポジ型感光性樹脂組成物には、必要によりレベリング剤、シランカップリング剤等の添加剤を添加することができる。本発明においてはこれらの成分を溶剤に溶解し、ワニス状にして使用する。溶剤としては、Nーメチルー2ーピロリドン、γープチロラクトン、N、Nージメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレ

ングリコールジプチルエーチル、プロピレングリコール モノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチ ルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル アセテート、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸プチル、メ チルー1、3ープチレングリコールアセテート、1、3 ープチレングリコールー3ーモノメチルエーテル、ピル ビン酸メチル、ピルビン酸エチル、メチルー3ーメトキ シブロピオネート等が挙げられ、単独でも混合して用い てもよい。

【0045】木発明のポジ型感光性樹脂組成物の使用方法は、まず談組成物を適当な支持体、例えば、シリコンウェハー、セラミック基板、アルミ基板等に塗布する。 塗布量は、半導体装置の場合、便化後の最終膜厚が 0.1~20μmになるよう塗布する。 膜厚が 0.1μm以下であると、半等体素子の保護表面膜としての機能を十分に発揮することが困難となり、20μm以上であると、微細な加工パターンを得ることが困難となるばかりでなく、加工に時間がかかりスループットが低下する。

(22)

特開平11-143070

42

41

塗布力法としては、スピンナーを用いた回転登布、スプ レーコーターを用いた噴霧塗布、浸液、印刷、ロールコ ーティング等がある。次に、60~130℃でプリペー クして登膜を乾燥後、所望のパターン形状に化学線を照 射する。化学線としては、X線、電子線、紫外線、可視 光線等が使用できるが、200~500nmの波長のも ので、特に365mmの波及が最も大きい効果を得るこ とが出来て好ましい。次に照射部を現像液で溶解除虫す ることによりレリーフパターンを得る。現像液として は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウ ム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモ ニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、ヵープロピ ルアミン等の第1アミン類、ジエチルアミン、ジーn-プロピルアミン等の第2アミン類、トリエチルアミン、 メチルジエチルアミン等の第3アミン類、ジメデルエタ ノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールア ミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テト **ワエチルアンモニウムヒドロキシド等の第4級アンモニ** ウム塩等のアルカリ類の水溶液、及びこれにメタノー ル、エタノールのごときアルコール類等の水路性有機溶 媒や界面活性剤を適当量添加した水溶液を好適に使用す ることができる。現像方法としては、スプレー、バド ・ル、浸漬、超音波等の方式が可能である。次に、現像に よって形成したレリーフパターンをリンスする。リンス 液としては、蒸留水を使用する。次に加熱処理を行い、 オキサソール環を形成し、耐熱性に富む最終パターンを 得る。本発明によるポジ型感光性樹脂組成物は、半導体 用途のみならず、多層回路の層間絶縁やフレキシブル銅 **張板のカバーコート、ソルダーレジスト膜や液晶配向膜** 等としても有用である。

[0046]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明する。

《実施例1》

*ポリアミドの合成

テレフタル酸 0.8 モルとイソフクル酸 0.2 モルと 1
ーヒドロキシー1,2、3ーベンゾトリアゾール 2 モル
とを反応させて得られたジカルボン酸誘導体 3 6 0.4
g(0.9 モル)とヘキサフルオロー2,2ーピス(3
ーアミノー4ーヒドロキシフェニル)プロパン3 6 6.40
3g(1.0 モル)とを温度計、提沖機、原料投入口、
乾燥窒素ガス導入管を備えた 4 つ口のセペラブルフラス
コに入れ、Nーメチルー2ーピロリドン3000gを加
えて溶解させた。その後オイルバスを用いて 7 5℃にて
1 2時間反応させた。次にNーメチルー2ーピロリドン
500gに溶解させた5ーノルボルネンー2、3ージカ
ルボン酸無水物 3 2.8g(0.2 モル)を加え、更に
1 2時間提拌して反応を終了した。反応混合物をろ過した後、反応混合物を水/メタノール= 3/1の容液に投
入、沈陰物を施集し水で充分洗浄した後、真空下で乾燥
50

し、一般式 (1) で示され、Xが下記式X-1、Yが下記式Y-1及びY-2の混合で、#=100、b=0からなる目的のポリアミド (A-1) を得た。

【0047】*ポジ製感光性樹脂組成物の作製 合成したポリアミド (A-I) 100g、下記式の構造 を有する1,2-ナフトキノン-2-ジアジド-4-スルホン酸エステル化合物 (Q-I) 10g、1,2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホン酸エステル化合物 (Q-2) 15g、下記式の構造を有するフェノール化合物 (P-I) 15gをN-メチル-2-ピロリドン200gに溶解した後、0.2μmのテフロンフィルターで濾過し感光性樹脂組成物を得た。

【0048】*特性評価

このポジ型感光性樹脂組成物をシリコンウェハー上にス ピンコーターを用いて強布した後、ホットプレートにて 120℃で4分乾燥し、膜厚約5μmの塗膜を得た。こ の盆膜に凸版印刷 (株) 製マスク (テストチャートN o. 1:幅0.88~50.0µmの残しパターンおよ び抜きパターンが描かれている)を通して高圧水銀灯を 用いて、フィルターより取り出した365ヵmの紫外光 線を鋸光母を変化させて照射した。次に1. 40%のテ トラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液に60秒浸 預することによって露光部を溶解除去した後、純水で3 O秒間リンスした。その結果、母光量170mJ/cm. *で照射した部分よりパターンが成形されていることが 確認できた。 (感度は170m J / c m²)。この時の 残廃率 (現像後の膜厚/現像前の膜厚×100) は8 9. 7%、解像度は4μmとそれぞれ非常に高い値を示 した。また、別にポジ型感光性樹脂組成物を同様にシリ コンウエハー上に塗布し、プリベークした後、オープン 中30分/150℃、30分/250℃、30分/35 0℃の概で加熱、樹脂を硬化させた後、この硬化膜の上 に半導体封止用エポキシ樹脂組成物(住友ベークライト (株)製、EME-6300H) を2×2×2mm (機× 縦×高さ〉の大きさに成形した。テンシロンを用いて、 ポリベンゾオキサゾール樹脂硬化膜上に成形した封止用 エポキシ樹脂組成物の剪断強度を測定した結果、3.5 kg/mm²であった。

【0049】《実施例2》実施例1における1,2ーナフトキノンー2ージアジドー4ースルボン酸エステル化合物(Q-1)の添加量を12.5g、1,2ーナフトキノンー2ージアジドー5ースルホン酸エステル化合物(Q-2)の添加量を12.5gに変えた他は実施例1と同様の評価を行った。

《実施例3》実施例1における1、2ーナフトキノンー2ージアジドー4ースルホン酸エステル化合物(Qー1)の能加量を5 g、1、2ーナフトキノンー2ージアジドー5ースルホン酸エステル化合物(Q-2)の添加量を20gに変えた他は実施例1と同様の評価を行った。

30

(23)

·:《実施例4》実施例1におけるフェノール化合物(P-.

1)を (P-2) に替えて、更に設成分の添加量を設1 の様に変えた他は箕座例1と同様の評価を行った。

《実施例 5》実施例 1 におけるフェノール化合物 (P-1) の添加量を5gにして、更に各成分の添加量を表1 の様に変えた他は実施例1と同様の評価を行った。

《実施例6》 実施例1におけるポリアミドの合成におい て、テレフタル酸0.8モルとイソフタル酸0.2モル の代わりに、ジフェニルエーテルー4、41 ージカルボ ン酸1モルに替えて、一般式 (1) で示され、Xが下記 式X-1、Yが下記式Y-3で、a=100、b=0か らなるポリアミド (A-2) を合成し、更に各成分の添 加量を表1の様に変えた他は実施例1と同様の評価を行 つた。

《実施例7》 実施例6 におけるポリアミドの合成におい て、ヘキサフルオロー2,2ービス(3ーアミノー4ー ヒドロキシフェニル) プロパン1モルの代わりに、3. 3 'ージアミノー4、4' ージヒドロキシジフェニルス ルホン1モルを用いて、一般式(1)で示され、Xが下 記式X-2、Yが下記式Y-3で、a=100、b=0 からなるボリアミド (A-3) を合成した。更に、1, 2ーナフトキノン-2-ジアジド-4-スルホン酸エス テル化合物 (Q-1) を (Q-3) に、1, 2-ナフト キノンー2ージアジドー5ースルホン酸エステル化合物 (Q-2)を(Q-4)に替え、更に各成分の添加量を 表1の様に変えた他は実施例1と同様の評価を行った。 《実施例8》 実施例1におけるポリアミドの合成におい て、ヘキサフルオロー2,2ービス(3ーアミノー4ー ヒドロキシフェニル) プロバンを348.0g(0.9 5モル)に滅らし、代わりに1,3ービス(3ーアミノ プロビル)ー1、1、3、3ーテトラメチルジシロキサ ン12.4g(0.05モル)を加え、一般式(1)で 示され、Xが下記式X-1、Yが下記式Y-1およびY -2の混合、2が下記式2-1で、a=95、b=5か らなるポリアミド (A-4) を合成した。更に各成分の 添加量を表1の様に変えた他は実施例1と同様の評価を

【0050】《比較例1》実施例1における1,2-ナ フトキノンー2ージアジドー4ースルホン酸エステル化 合物(Q-1)の添加盘を0g、1,2ーナフトキノン -2-ジアジド-5-スルホン酸エステル化合物(Q-2) の添加量を25gに変えた他は実施例1と同様の評 価を行った。

《比較例2》 実施例1における1, 2ーナフトキノンー 2-ジアジドー4ースルホン酸エスチル化合物(Q-1) の添加量を2g、1, 2-ナフトキノン-2-ジア ジドー5-スルポン酸エステル化合物(Q-2)の添加 量を23gに替え、更に各成分の添加量を設1の様に変 えた他は実施例 I と同様の評価を行った。

《比較例3》実施例1における1、2ーナフトキノンー 2ージアジドー4ースルホン酸エステル化合物(Qー 1) の添加量を20g、1, 2-ナフトキノン-2-ジ アジドー5-スルポン酸エステル化合物(Q-2)の添 加量を5gに替え、更に各成分の添加量を表1の様に変 えた他は実施例1と同様の評価を行った。

《比較例4》 実施例6 におけるフェノール化合物の添加 盤を0.5gに減らし、更に各成分の添加量を表1の様 に変えた他は実施例1と同様の評価を行った。

《比較例5》実施例6におけるフェノール化合物の添加。 量を40gに増やし、更に各成分の添加量を表1の様に 変えた他は実施例1と同様の評価を行った。

《比較例 6》 実施例 1 におけるフェノール化合物 (P-1) を (P-3) に変えた他は実施例1と回模の評価を 行った。以上実施例1~8、比較例1~6の評価結果を 表1に示す。

[0051] 【化31】

[0052]

待開平11-143070

を示し、Q全体の内、70%が

である。

0 0

を示し、Q全体の内67%が

である。)

[0053]

[化33]

· (26)

特開平11-143070

. 50

(式中Qは水素原子又は

を示し、Q全体の内、75%が

である。)

Q-4:

(式中Qは水素原子又は

を示し、Q全体の内70%が

である。)

[化34]

[0054]

[0055]

【表1】

	配合量						价值				
	#'974)* (A) (100g)		1,2-17/1/2	1,2-ナフトキノン	7=1-1	感度 (m)/cm?	残散率 (%)	解論应 (pin)	せん斯 樹着強度		
			-2-9"79" F	-3-9779 ド -5-3842歌	化自物						
			-1-25秒段								
i			化合物	化合物							
	アミン	歐	(B)	(C)	(כס)		İ	ļ	(kg/mar)		
			(g)	(g)	(<u>e</u>)				<u>. </u>		
为推约 1	X-1	Y-1.1-2	Q-1 10	Q-3 , L5	P-I 15	170	89.7	4	3.5		
双独约 1	I-t	Y-1, Y-2	Q-1 12.5	9-2 12.5	P-1 15	170	88.5		3.3		
FIRE PLANTS	X-1	Y-1, Y-2	Q-1 5	Q-2 10	P-1 15	180	91.2	6	3.6		
深遊門4	I-t	Ý-1. Y-2	Q—1 10	Q-2 15	P-2 12	150	87.6	4	3.6		
內質例 6	I -1	Y-1.Y-2	Q-1 10	Q-2 12	P-1 5	190	92. D	5	3.2		
次田田 6	· I-1	Y-3	Q-1 g	0-2 11	P-1 12	190	89.4	6	3.€		
奥田何7	χ́~3	Y-3	9-3 10	0-4 15	P-1 12	200	93.8		7.5		
支持的	X-1/3-1	7-1.Y-3	Q-1 10	0-3 10	P-1 12	170	88, 6	6	3.5		
	98/5モル鬼			1							
比较例:	I-1	Y-1, Y-8	3- 3 0	Q-2 25	P-1 15	260	93.5	5	3.4		
12,820713	X-1	Y-3, Y-2	Q-1 2	Q-2 23	P-1 10	288	B\$. 6	6	8.4		
建設網3	X-9	Y-1. Y-1	Q-1 20	0-5 6	P-1 12	(TD	88.9	12	8.3		
上校网6	X-1	7-3	Q-1 8	Q-2 12	P-1 0.5	120	54. Z	-	2, 1		
比較何も	X-I	Y-3	Q-I 12	9-2 17	P-1 40	180	6G. 1	4	2, 3		
比較例6	X-1	Y-1, Y-2	Q-1 10	Q-2 15	7-3 15	270	52. O	1	3.0		

[0056] # 評価結果

実施例1~3と比較例1~3は、共に1,2ーナフトや ノンー2ージアジドー4ースルホン酸エステル化合物 (Q-1) と1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-6

-スルホン酸エステル化合物 (Q-2) の添加量による

50 評価である。Q-1の添加量が0である比較例1は、高

(28)

特開平 (1-14307D

54

磁度の効果が認められない。10<(C)/(B)である比較例2の場合も同様に高磁度の効果が弱いために認められない。(C)/(B)<1である比較例3では良好な協度を示すも、Q-1の溶解性が高いために露光部と未露光部の溶解度差がつきにくくなるために解像度が低下している。実施例1、4、5と比較例4~6は、フェノール化合物の種類と量による評価である。P-1の添加量が1重量部未満である比較例4の場合はあまり高磁度化していないばかりか、對止樹脂との密着性が低下

している。P-1の添加量が30重量部以上である比較例5は、溶解性が高すぎるため残膜率が若しく低下している。フェノール化合物の種類をP-3に代えた比較例6は高残膜率なるも感度が低下している。

[0057]

フロントページの総合

(51) Int. Cl. 5

微別配号

// CO9D 177/06

F I

HOIL 21/30

502R

(72) 発明者 平野 幸

東京都品川区東品川 2丁目 5番8号 住友 ベークライト株式会社内